



中华人民共和国国家标准

GB/T 29055—2012

太阳能电池用多晶硅片

Multi-crystalline silicon wafer for solar cell

2012-12-31 发布

2013-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
太阳电池用多晶硅片
GB/T 29055—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年4月第一版

*

书号: 155066·1-46637

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)归口。

本标准起草单位:江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司、宁波晶元太阳能有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司。

本标准主要起草人:万跃鹏、唐骏、孙世龙、游达、朱华英、刘林艳、段育红。

太阳能电池用多晶硅片

1 范围

本标准规定了太阳能电池用多晶硅片的术语定义、符号及缩略语、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于铸锭多晶切片垂直于长晶方向生产的太阳能电池用多晶硅片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551 硅单晶电阻率测定方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 29054 太阳能级铸造多晶硅块

SEMI MF1535 用微波反射非接触光电导衰减方法测试硅晶片载流子复合寿命的方法

3 术语和定义

GB/T 14264 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

密集线痕 dense saw mark

硅块切割时,在硅片表面留下的密集型划痕。

4 外形尺寸分类

太阳能电池用多晶硅片的规格系列见表1,在表1中未列出的尺寸规格要求由供需双方协商。

表1 太阳能电池用多晶硅片规格系列

外形尺寸/mm	125×125	156×156
硅片厚度/ μm	160	
	180	
	200	
	220	